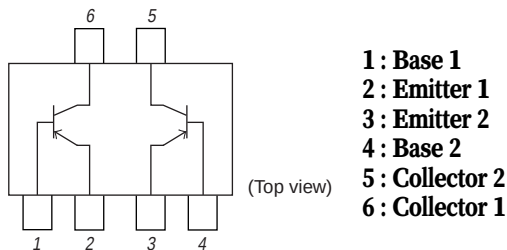


前ページより続く。

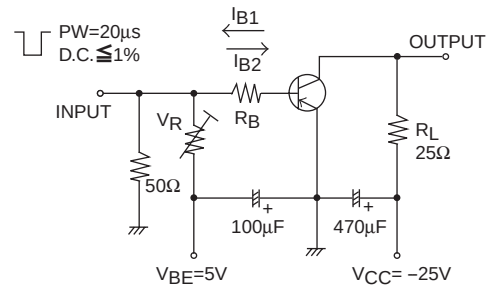
			min	typ	max	unit
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)1}$	$I_C = -1A, I_B = -50mA$		-105	-180	mV
	$V_{CE(sat)2}$	$I_C = -2A, I_B = -100mA$		-200	-340	mV
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -2A, I_B = -100mA$		-0.89	-1.2	V
コレクタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C = -10\mu A, I_E = 0$	-50			V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CES}$	$I_C = -100\mu A, R_{BE} = 0$	-50			V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -1mA, R_{BE} = \infty$	-50			V
エミッタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -10\mu A, I_C = 0$	-6			V
ターンオン時間	t_{on}	指定回路において		30		ns
蓄積時間	t_{stg}	"		230		ns
下降時間	t_f	"		15		ns

注) 各規格は個々のトランジスタに対しての特性を表している。

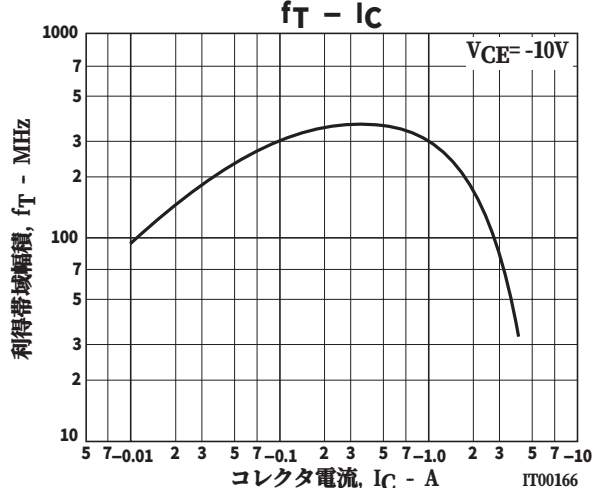
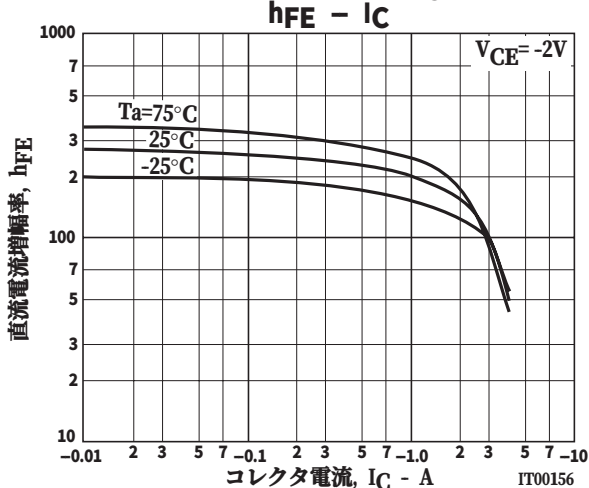
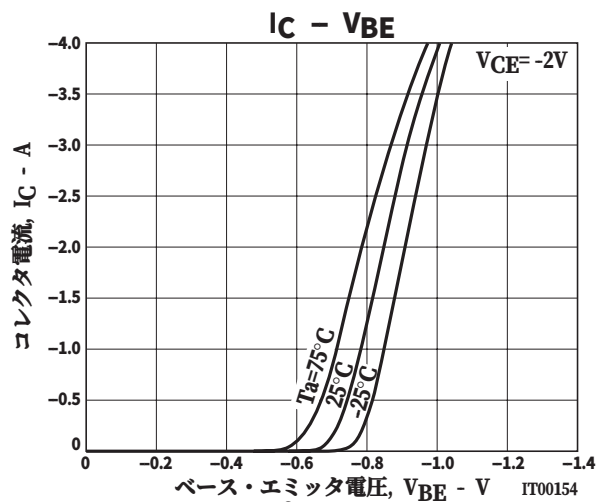
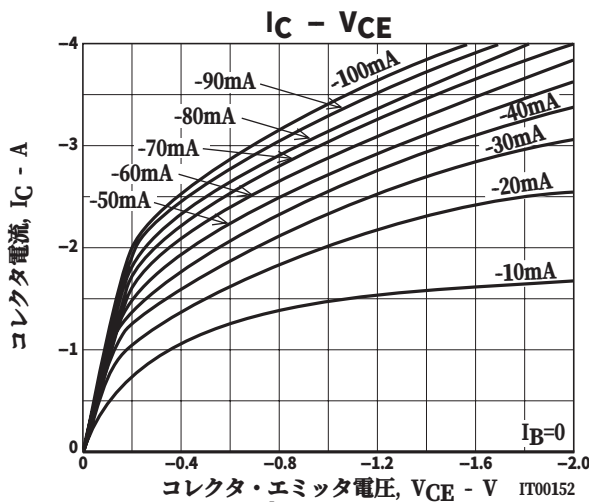
電氣的接続図



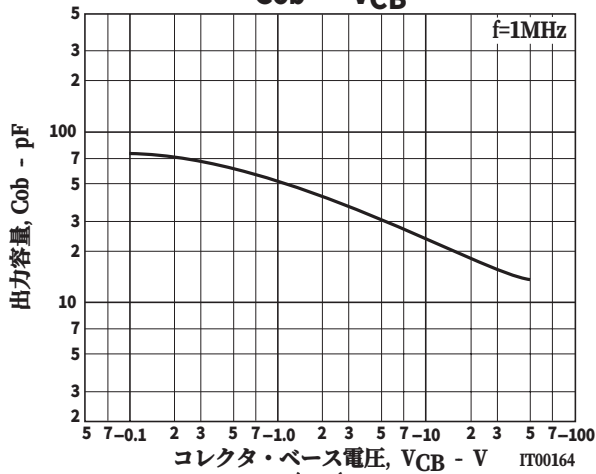
スイッチングタイム測定回路図



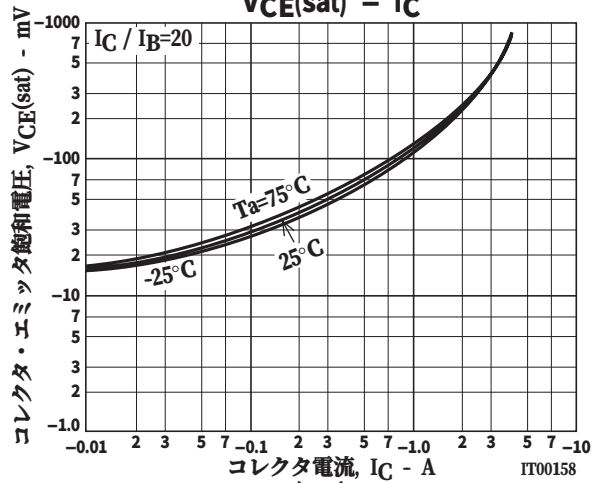
$$I_C = -10I_{B1} = 10I_{B2} = -1A$$



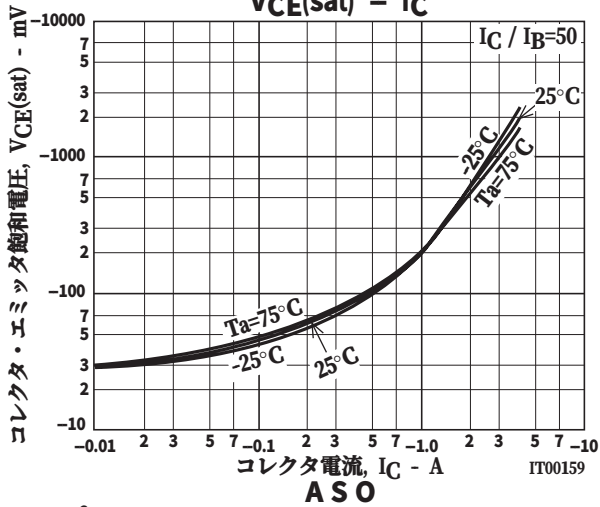
Cob - VCB



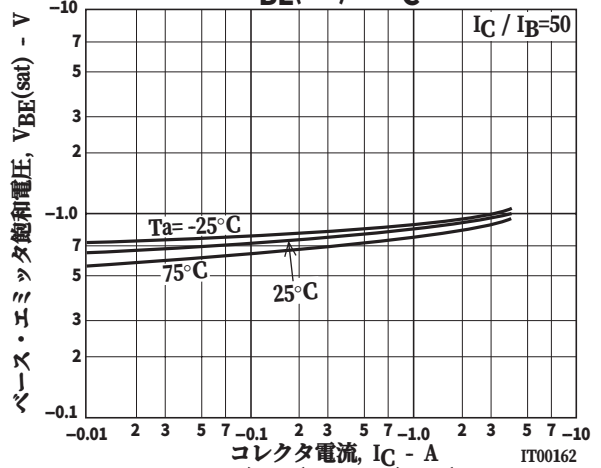
VCE(sat) - IC



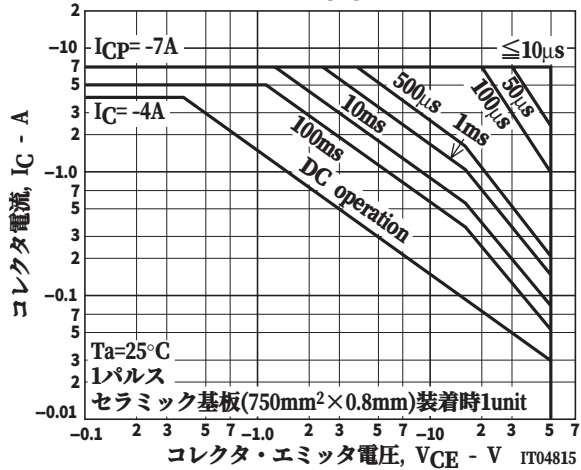
VCE(sat) - IC



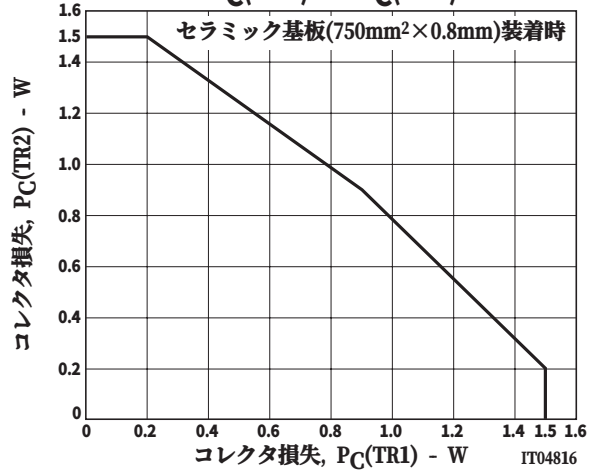
VBE(sat) - IC



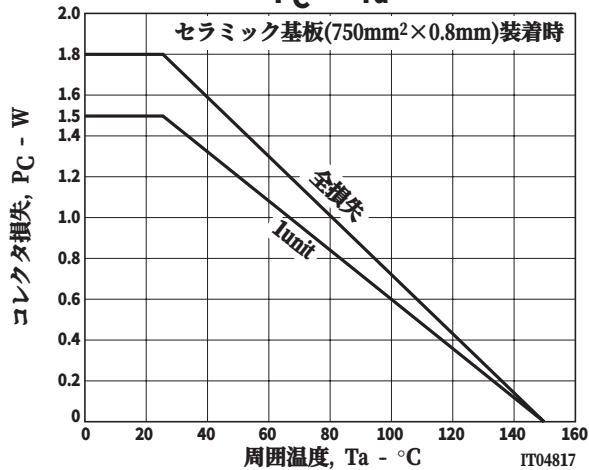
ASO



PC(TR2) - PC(TR1)



PC - Ta



- 本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであり、お客様の製品（機器）での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。
- 弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めております。しかし、半導体製品はある確率で故障が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかわる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与えてしまう事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないような、保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。
- 本書記載の製品が、外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物（役務を含む）に該当する場合、輸出する際に同法に基づく輸出許可が必要です。
- 弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。
- 本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。したがって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。
- この資料の情報（掲載回路および回路定数を含む）は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証するものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたって第三者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。